

05;06;12
©1995 г.

ДЕГРАДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОРИСТЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Ю.М. Волокобинский, Т.И. Диалло, К.О. Кравченко

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет,
197376, Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 7 июля 1994 г.)

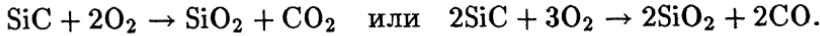
Рассмотрена теория явлений, происходящих в пористой карбидкремниевой керамике при высоких температурах, положенная в основу моделирования на ЭВМ деградационных процессов, связанных с окислением.

Карбидкремниевая керамика применяется в электронике при изготавлении нагревателей и другого технологического оборудования [1]. В процессе работы изделий из карбида кремния при высоких температурах на воздухе наблюдается увеличение их массы m , которая возрастает со временем t в соответствии с эмпирическим выражением [2]

$$\Delta m/m_0 = \alpha[\exp(-W/kT)]t^\beta, \quad (1)$$

где $\Delta m = m - m_0$, m_0 — исходное значение массы; α и β — коэффициенты, величина которых зависит от формы и размеров деталей, структуры материала, содержания и химической природы легирующих добавок и режима эксплуатации; k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; $W = 0.4\text{--}0.6\text{ эВ}$ — энергия активации.

Согласно теоретическим представлениям [3], прирост массы связан с реакциями окисления карбида кремния



Реакция окисления происходит на поверхности зерен карбида кремния, причем на одну молекулярную единицу SiC образуется одна молекула SiO_2 , остающаяся на поверхности зерна, которая постепенно покрывается слоем окисла кремния. Так как масса молекулы SiO_2 больше массы молекулы SiC , то окисление карбидкремниевой керамики приводит к увеличению ее массы и веса. Масса молекулы SiC составляет 40 а.е.м., а масса SiO_2 — 60 а.е.м. Следовательно, вес продукта реакции окисления больше веса вступившего в реакции карбида кремния в $m_{\text{SiO}_2}/m_{\text{SiC}} = 1.5$ раз. Объем образовавшегося окисла SiO_2 также больше объема прореагировавшего SiC. Действительно, плотность

высокотемпературной гексагональной или ромбической модификации карбида кремния $\rho_{\text{SiC}} = 3.16 \text{ г}/\text{см}^3$, нарастающего на поверхности зерен окисла $\rho_{\text{SiO}_2} = 2.3 \text{ г}/\text{см}^3$, отношение объемов

$$\varkappa = \frac{V_{\text{SiO}_2}}{V_{\text{SiC}}} = \frac{m_{\text{SiO}_2}}{m_{\text{SiC}}} \frac{\rho_{\text{SiC}}}{\rho_{\text{SiO}_2}} = 2.06.$$

Эксперименты, проведенные на воздухе при давлении, близком к нормальному, показали, что в интервале температур $1000\text{--}1600^\circ\text{C}$ $\beta \simeq 0.5$. Это свидетельствует о том, что скорость прироста массы определяется процессом реактивной диффузии, приводящим к временной зависимости (1).

При расчете процесса окисления требуется решать уравнение Фика

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \operatorname{div}(D \operatorname{grad} n), \quad (2)$$

где n — концентрация избыточного кислорода в пленке окисла, D — коэффициент диффузии кислорода, с учетом структуры образца и условий эксплуатации.

Микроскопическое исследование сколов и шлифов материала карбидкремниевых нагревателей и моделирование на ЭВМ их структуры с помощью метода Монте-Карло, результаты которого представлены на рис. 1, показывает, что можно выделить участки плоской, цилиндрической и сферической поверхности зерен и пор. Следовательно, при детальном математическом описании необходимо рассматривать процессы окисления пластин, стержней и сфер, а также в цилиндрических и сферических порах.

Для удобства сопоставления результатов приведем расчет пластины толщиной $H = 2R$, окисляемой с двух сторон, стержня и сферы радиуса R , считая, что в исходный момент времени $t = 0$ поверхность не окислена, а затем на ней постепенно нарастает слой SiO_2 . Окисление связано с проникновением избыточного кислорода из атмосферы в окисел и диффузией его к поверхности зерна SiC . В приближении примем, что на внешней поверхности окисла, соприкасающейся с атмосферой, концентрация избыточного кислорода равна равновесной n_0 , а на внутренней, граничащей с SiC , концентрация избыточного кислорода $n_s = 0$. Согласно [4], при температуре 1000°C и давлении 560 Тор $n_0 = 1.1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$; при нагревании n_0 уменьшается несколько быстрее, чем плотность воздуха и концентрация в нем кислорода при постоянном давлении.

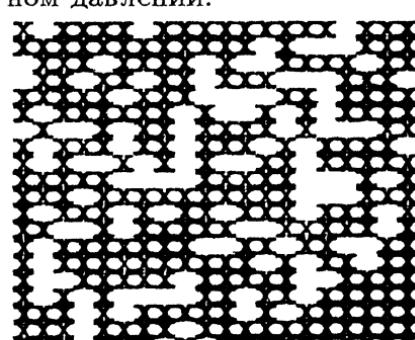


Рис. 1. Теоретическая модель образца со средней пористостью 30 об.%.
В поле зрения 28% площади занято порами;
— зерна, пробелы — поры.

Коэффициент диффузии кислорода D резко возрастает при повышении температуры

$$D = D_0 \exp(-Q/kT), \quad (3)$$

так что в общем случае при учете тепловых полей в образцах уравнение (2) решается численными методами, однако, принимая во внимание малые размеры зерен и пор, перепадом температур в них можно пренебречь и получить аналитическое решение.

Процесс окисления кремния хорошо изучен теоретически и экспериментально [5–7], и известные решения для пластины приводятся ниже лишь для того, чтобы с ними сопоставить новые результаты. В приближении принимается, что в плоском слое устанавливается режим переноса, при котором плотность потока кислорода j не зависит от координаты x . Следовательно, предполагается, что градиент концентрации также постоянен по толщине слоя SiO_2 и равняется

$$\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{n_0 - n_s}{h}, \quad (4)$$

толщина окисла и на поверхности пластины возрастает по закону

$$\frac{h^2}{2} = \frac{V_1 D n_0}{2} t + \text{const} = \frac{A}{2} t + \text{const}, \quad (5)$$

где V_1 — объем, приходящийся на одну группу SiO_2 , $V_1 = 4.35 \cdot 10^{-23} \text{ см}^3$.

Считая, что при $t = 0$ $h = 0$, из (5) найдем

$$h = \sqrt{A} \sqrt{t} = 6.6 \cdot 10^{-12} \sqrt{D n_0} \sqrt{t} (\text{см}), \quad (6)$$

где t выражено в с, D — в $\text{см}^2/\text{с}$, n_0 — в см^{-3} .

Толщина растущего слоя SiO_2 больше толщины окисленного SiC , и приращение массы из-за окисления в расчете на единицу поверхности пластины вычисляется по формуле

$$\Delta m_1 = 5.06 \cdot 10^{-12} \sqrt{D n_0} \sqrt{t} (\text{г}/\text{см}^2). \quad (7)$$

Пластина из карбида кремния полностью окислится за время t_0 , когда толщина окисла на каждой ее поверхности станет равной κR и, как следует из (5),

$$\frac{\kappa^2 R^2}{2} = \frac{A}{2} t_0. \quad (8)$$

Относительное увеличение массы пластины можно выразить через толщину слоя окисла

$$\frac{\Delta m}{m_0} = \frac{(\kappa \rho_{\text{SiO}_2} - \rho_{\text{SiC}})}{\rho_{\text{SiC}}} \frac{2h}{H \kappa} = 0.5 \frac{2h}{H \kappa}. \quad (9)$$

При полном окислении масса возрастает в 1.5 раз.

Как известно, предположение о независимости плотности потока кислорода j от x выполняется, если пренебречь временной зависимостью n и при решении уравнения (2) положить $\partial n / \partial t = 0$. Такое упрощение приводит к малой погрешности расчета.

Решая в цилиндрической системе координат задачу для стержня, имеющего в неокисленном состоянии радиус R , найдем при этом же упрощении, что со временем t нарастает слой окисла с внутренним и внешним радиусами r_1 и r_2 соответственно, причем $r_1 < R < r_2$ и

$$r_2^2 = \kappa R^2 - (\kappa - 1)r_1^2. \quad (10)$$

Внутренний радиус r_1 связан с t соотношением

$$r_1^2 \ln r_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\kappa}{\kappa - 1} R^2 - r_1^2 \right) \ln [\kappa R^2 - (\kappa - 1)r_1^2] - \frac{\kappa}{\kappa - 1} R^2 \ln R = \frac{A}{\kappa} t. \quad (11)$$

Концентрация избыточного кислорода n в слое окисла определяется выражением

$$n = n_0 \frac{\ln(r/r_1)}{\ln(r_2/r_1)}. \quad (12)$$

Стержень полностью окисляется за время t_c

$$t_c = \frac{1}{2A} \frac{\kappa^2}{\kappa - 1} (\ln \kappa) R^2. \quad (13)$$

Отношение времен окисления стержня радиуса R и пластины толщиной $H = 2R$ можно найти, исходя из (8) и (13),

$$\vartheta = \frac{t_c}{t_0} = \frac{\ln \kappa}{2(\kappa - 1)}. \quad (14)$$

Для изделий из карбида кремния это отношение составляет $\vartheta = 0.342$. Таким образом, при указанных размерах окисление стержня из карбида кремния завершится примерно в 3 раза быстрее пластины.

Интересно сравнить времена окисления при выбранных выше размерах в случае, когда $\kappa = 1$, т. е. толщина окисла такая же, что и исходного материала, вступившего в реакцию. В этом случае числитель и знаменатель в (14) обращаются в нуль. Раскрывая неопределенность по правилу Лопиталля, получим, что $\vartheta = 0.5$.

При окислении сферической частицы, имевшей в исходный момент времени $t = 0$ радиус R , на ее поверхности нарастает слой с внутренним r_1 и внешним радиусами r_2 , связанными соотношением

$$r_2^3 = \kappa R^3 - (\kappa - 1)r_1^3. \quad (15)$$

Закон изменения r_1 со временем определяется выражением

$$\kappa \left\{ R^2 - r_1^2 + \frac{R^2}{\kappa - 1} - \frac{[\kappa R^3 - (\kappa - 1)r_1^3]^{2/3}}{\kappa - 1} \right\} = At. \quad (16)$$

Сферическая частица полностью окисляется за время

$$t_s = \frac{\kappa}{A} \left(1 - \frac{\kappa^{2/3} - 1}{\kappa - 1} \right) R^2. \quad (17)$$

Отношение времен полного окисления сферы радиуса R и пластины толщиной $H = 2R$ получим, исходя из (8) и (17),

$$\theta = \frac{t_s}{t_0} = \frac{1 - \kappa^{-1/3}}{\kappa - 1}. \quad (18)$$

Для карбида кремния $\theta = 0.2$, а для материалов с $\kappa = 1$ $\theta = 1/3$.

При окислении цилиндрической поры, имевшей в исходный момент времени $t = 0$ радиус R , внешний радиус слоя SiO_2 r_2 возрастает, а внутренний радиус r_1 убывает со временем

$$r_2^2 \ln r_2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\kappa}{\kappa - 1} R^2 - r_2^2 \right) \ln [\kappa R^2 - (\kappa - 1)r_2^2] - \frac{\kappa}{\kappa - 1} R^2 \ln R = \frac{A}{\kappa} t, \quad (19)$$

$$r_1^2 = \kappa R^2 - (\kappa - 1)r_2^2. \quad (20)$$

Окисление прекращается в момент времени t_1 , когда пора полностью заполняется окислом,

$$t_1 = \frac{\kappa^2}{2A(\kappa - 1)} \left(\ln \frac{\kappa}{\kappa - 1} \right) R^2. \quad (21)$$

Для шаровой поры аналогичные зависимости имеют вид

$$\kappa \left\{ R^2 - r_2^2 + \frac{R^2}{\kappa - 1} - \frac{[\kappa R^3 - (\kappa - 1)r_2^3]^{2/3}}{\kappa - 1} \right\} = At, \quad (22)$$

$$r_1^3 = \kappa R^3 - (\kappa - 1)r_2^3. \quad (23)$$

Окисление шаровой поры завершается за время

$$t_2 = \frac{\kappa}{A} \left[\frac{\kappa}{\kappa - 1} - \left(\frac{\kappa}{\kappa - 1} \right)^{2/3} \right] R^2. \quad (24)$$

При моделировании процессов деградации изделий из карбида кремния в сухом очищенном воздухе при температурах 1400°C и выше величина коэффициента A , входящего в выражения (5)–(24), вычислялась по формуле

$$A = A_0 \exp \left(-\frac{Q}{kT} \right), \quad (25)$$

где $A_0 = 19 \text{ мкм}^2/\text{ч}$ и $Q = 0.96 \text{ эВ}$.

Зависимость h от t для пластины можно записать в виде

$$h = B\sqrt{t} = B_0 \exp \left(-\frac{W}{kT} \right) \cdot \sqrt{t}, \quad (26)$$

где $B_0 = 4.45 \text{ мкм}/\text{ч}^{0.5}$ и $W = 0.48 \text{ эВ}$.

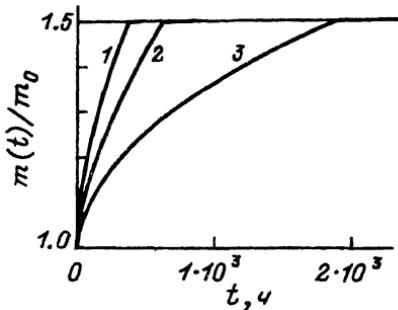


Рис. 2. Зависимость прироста массы при окислении.

1 — сферического, 2 — цилиндрического образцов диаметром 10 мкм, 3 — пластины толщиной 10 мкм.

При $T = 1400^\circ\text{C}$ $A_0 = 0.024 \text{ мкм}^2/\text{ч}$ и $B_0 = 0.154 \text{ мкм}/\text{ч}^{0.5}$.

Моделирование позволяет оценить влияние структуры нагревателей на скорость процессов деградации. Например, на рис. 2 представлена зависимость относительного изменения массы $m(t)/m_0$ сферических и цилиндрических частиц радиуса $R = 10 \text{ мкм}$ и пластинок толщиной $H = 2R$ от времени t при температуре 1400°C . Используя кривые рис. 2 и учитывая, что время полного окисления пропорционально R^2 , можно построить временные зависимости $m(t)/m_0$ и при других размерах зерен.

Теоретические расчеты согласуются с результатами экспериментальных исследований на выборке в 100 штук нагревателей, имевших в исходном состоянии среднюю величину сопротивления, несколько превышающую 1 Ом. При температуре 1400°C и воздействии атмосферного воздуха 23 нагревателя вышли из строя из-за нарушения контактов, остальные — в связи с увеличением сопротивления выше допустимого предела. Наблюдался большой разброс экспериментальных результатов, которые не подчинялись закону нормального распределения. Сопротивление нагревателей возросло на 100% за 1000–1600 ч (в среднем примерно за 1300 ч) и на 300% — за 1600–2200 ч. На первом этапе средняя скорость изменения сопротивления составляла 0.77 мОм/ч . Эта скорость пропорциональна удельной поверхности S открытых пор. S может быть измерена и приближенно оценена теоретически. В случае пор произвольной формы

$$S = \frac{(2-3)\nu}{100} \frac{\nu}{R} (\text{см}^2/\text{см}^3), \quad (27)$$

где R — средний радиус цилиндрической или сферической поры (см), ν — содержание открытых пор (об.%).

В целях уменьшения скорости возрастания сопротивления на начальном этапе желательно уменьшать ν и увеличивать средние размеры зерен. Известно, что при плотной упаковке одинаковых шаров пористость составляет 26 об.%. Уменьшение пористости достигается путем изготовления нагревателей из зерен нескольких различающихся размерами фракций. Основу составляют крупные зерна размерами в сотни микрон, зерна средних и мелких размеров добавляют для заполнения пустот. Кроме того, вводятся примеси, способствующие поверхностной диффузии и облегчающие спекание, что позволяет снизить пористость до 20 об.% и менее.

Существенно, что при увеличении пористости от 20 до 30 об.% резко возрастает вероятность образования на пути тока перешейков, состо-

ящих из отдельных зерен, представляющих наибольшую опасность в связи с окислением и перегоранием.

Теория позволяет проанализировать процессы, происходящие в нагревателях при эксплуатации, и с учетом режима использования рекомендовать наиболее целесообразные технологические приемы их изготовления, применяя которые можно в несколько раз увеличить срок работы.

Список литературы

- [1] Гнесин Г.Г. Карбидокремниевые материалы. М.: Металлургия, 1977.
 - [2] Авров Д.Д. Канд. дис. СПб., 1992.
 - [3] Кайнарский И.С., Дегтярева Э.В. Карборундовые оgneупоры. Свойства карбида кремния, технология и применение карборундовых оgneупоров. Харьков: Металлургиздат, 1963.
 - [4] Ronald L. Meek // J. Amer. Cer. Soc. 1973. June. P. 341.
 - [5] Mott N.F. // Phil. Mag. 1987. Vol. B55. N 2. P. 117.
 - [6] Deal B.E., Grove A.S. // Phil. Mag. 1987. Vol. B55. N 2. P. 131.
 - [7] Глухонький К.Г., Зайцев Н.А., Суровиков М.В. // Электронная техника. Сер. 6. Материалы. 1991. Вып. 1 (255). С. 3.
-